ロ　最大動作周波数が二〇ギガヘルツ以上のものであって、光挿入損失が三デシベル以下のもののうち、次のいずれかに該当するもの

（一）　一ギガヘルツ以下の周波数で測定した場合の半波長電圧が三・三ボルト未満のもの

（二）　一ギガヘルツを超える周波数で測定した場合の半波長電圧が五ボルト未満のもの

九　［略］

十　アナログデジタル変換器のうち、アナログデジタル変換を行う機能を有するモジュール、組立品又は装置（アナログデジタル変換カード、波形デジタイザー、データ収集カード、信号収集ボード及びトランジェントレコーダーを含む。）であって、次のイ及びロに該当するもの（デジタル方式の記録装置、サンプリングオシロスコープ、スペクトラムアナライザー、信号発生器、ネットワークアナライザー及びマイクロ波用試験受信機を除く。）

イ　分解能及びサンプルレートが次のいずれかに該当するもの

（一）　分解能が八ビット以上一〇ビット未満のものであって、サンプルレートが一・三ギガサンプル毎秒を超えるもの

（二）　分解能が一〇ビット以上一二ビット未満のものであって、サンプルレートが一ギガサンプル毎秒を超えるもの

（三）　分解能が一二ビット以上一四ビット未満のものであって、サンプルレートが一ギガサンプル毎秒を超えるもの

（四）　分解能が一四ビット以上一六ビット未満のものであって、サンプルレートが四〇〇メガサンプル毎秒を超えるもの

（五）　分解能が一六ビット以上のものであって、サンプルレートが一八〇メガサンプル毎秒を超えるもの

ロ　［略］

十一　［略］

十二　スペクトラムアナライザーであって、次のいずれかに該当するもの

イ　三一・八ギガヘルツ超三七ギガヘルツ以下のいずれかの周波数帯域で、三デシベルの分解能帯域幅が四〇メガヘルツを超えるもの

ロ～ニ　［略］

十三～十六の二　［略］

十七　半導体素子、集積回路若しくは半導体物質の製造用の装置（ホにおいて「半導体製造装置」という。）若しくは試験装置若しくは集積回路の製造用のマスク若しくはレチクルであって、次のいずれかに該当するもの又はこれらの部分品若しくは附属品

イ～ヘ　［略］

ト　マスク又はレチクルであって、第一号から第八号の四までのいずれかに該当する集積回路の製造用のもの

チ　位相シフト膜を有する多層マスクであって、次のいずれかに該当するもの（トに該当するもの及び第一号から第八号の四までのいずれにも該当しない記憶素子を製造するために設計したものを除く。）

（一）・（二）　［略］

九　［略］

十　アナログデジタル変換器のうち、アナログデジタル変換を行う機能を有するモジュール、組立品又は装置（アナログデジタル変換カード、波形デジタイザー、データ収集カード、信号収集ボード及びトランジェントレコーダーを含む。）であって、次のイ及びロに該当するもの（デジタル方式の記録装置、サンプリングオシロスコープ、スペクトラムアナライザー、信号発生器、ネットワークアナライザー及びマイクロ波用試験受信機を除く。）

イ　分解能及びサンプリング速度が次のいずれかに該当するもの

（一）　分解能が八ビット以上一〇ビット未満のものであって、入力速度が一・三ギガサンプル毎秒を超えるもの

（二）　分解能が一〇ビット以上一二ビット未満のものであって、入力速度が一ギガサンプル毎秒を超えるもの

（三）　分解能が一二ビット以上一四ビット未満のものであって、入力速度が一ギガサンプル毎秒を超えるもの

（四）　分解能が一四ビット以上一六ビット未満のものであって、入力速度が四〇〇メガサンプル毎秒を超えるもの

（五）　分解能が一六ビット以上のものであって、入力速度が一八〇メガサンプル毎秒を超えるもの

ロ　［略］

十一　［略］

十二　スペクトラムアナライザーであって、次のいずれかに該当するもの

イ　三一・八ギガヘルツ超三七ギガヘルツ以下のいずれかの周波数帯域で、三デシベルの分解能帯域幅が一〇メガヘルツを超えるもの

ロ～ニ　［略］

十三～十六の二　［略］

十七　半導体素子、集積回路若しくは半導体物質の製造用の装置（ホにおいて「半導体製造装置」という。）若しくは試験装置若しくは集積回路の製造用のマスク若しくはレチクルであって、次のいずれかに該当するもの又はこれらの部分品若しくは附属品

イ～ヘ　［略］

ト　マスク又はレチクルであって、第一号から第八号の三までのいずれかに該当する集積回路の製造用のもの

チ　位相シフト膜を有する多層マスクであって、次のいずれかに該当するもの（トに該当するもの及び第一号から第八号の三までのいずれにも該当しない記憶素子を製造するために設計したものを除く。）

（一）・（二）　［略］